

Спосіб вирощування монокристала кремнію з розплаву, що включає формування газового потоку над розплавом у присутності екрана, розташованого над площиною розплаву співвісно вирощуваному монокристалу кремнію, який **відрізняється** тим, що використовують циліндричний екран, нижній кінець якого розміщують над площиною розплаву на висоті, що розрахована за формулою:

$$h = (A - D) / B,$$

де  $h$  - висота розміщення нижнього кінця екрана над рівнем розплаву, мм,

$D$  - заданий діаметр вирощуваного зливка монокристала кремнію, що знаходиться в межах 75-150 мм,

$A$  - розмірний коефіцієнт, що знаходиться в межах 210-240,

$B$  - коефіцієнт, що знаходиться в межах 4,6-5,0, і при цьому діаметр циліндричного екрана дорівнює 235-245 мм.